

عنوان فارسی مقاله :

مشخصات RF ترانزیستور CMOS  $0.18\text{-}\mu\text{m}$

عنوان انگلیسی مقاله :

RF Characteristics of  $0.18\text{-}\mu\text{m}$  CMOS Transistors

توجه !



این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی

مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

## II. MEASUREMENT

Multi-finger type MOSFETs were laid out with a common-source configuration. Scattering parameters were measured in devices with various unit finger lengths ( $L_f$ ). Measurements of the scattering parameters were carried out in the frequency range of 0.5~50 GHz by using on-wafer RF probes and a HP8510C vector network analyzer (VNA). The power level of the incident wave was -10 dBm. A ground-signal-ground (GSG) pad was used. System calibration with an ISS (impedance-standard substrate) was done to extend the reference plane to the probe tips. Two-step de-embedding, which includes open and short de-embedding, was performed.



2. اندازه‌گیری‌ها  
تعداد انگشت‌شماری از انواع MOSFET با یک پیکربندی منبع-مشترک وجود دارند. پارامترهای پراکندگی در وسایل با طول‌های مختلف واحد انگشت اندازه‌گرفته شده است ( $L_f$ ). اندازه‌گیری‌های پارامترهای پراکندگی در محدوده فرکانس 0.5 تا 50 GHz با استفاده از پروب RF بر روی ویفر و بردار HP8510c تحلیل‌گر شبکه (VNA) انجام شده است. سطح توان موج القایی برابر 10 dBm است. پد زمین-سیگنال-زمین (GSG) استفاده شده است. کالبیره‌سازی سیستم با ISS (بستر استاندارد امپدانس) برای بسط طرح مرجع به نکات پروب انجام گرفته است. دو مرحله تعبیه‌سازی، شامل تعبیه‌سازی باز و کوتاه است، مجاز است.

توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه می باشد.

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

همچنین برای مشاهده سایر مقالات این رشته [اینجا](#) کلیک نمایید.